

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 6 月 8 日 (2006.6.8)

【公開番号】特開 2002-184427 (P2002-184427A)
 【公開日】平成 14 年 6 月 28 日 (2002.6.28)
 【出願番号】特願 2000-376772 (P2000-376772)
 【国際特許分類】

H 0 1 M 8/02 (2006.01)
C 0 8 G 77/56 (2006.01)
C 0 8 J 5/18 (2006.01)
C 0 8 L 83/14 (2006.01)
C 0 8 L 101/00 (2006.01)
H 0 1 M 8/10 (2006.01)

【F I】

H 0 1 M 8/02 P
 C 0 8 G 77/56
 C 0 8 J 5/18 C F H
 C 0 8 L 83/14
 C 0 8 L 101/00
 H 0 1 M 8/10

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 4 月 14 日 (2006.4.14)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 1
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 2 1】

実施例 5

実施例 1 で調製したヘキシル基を含まないボロシロキサン電解質生成物に、10 重量 % のスチレン - イソブレン - スチレンブロック共重合体 (S I S) をブレンドした電解質を次の方法で調製した。

S I S 0.036 g をトルエン溶媒 (1 m l) 中に均一な溶液になるまで溶かした。すり鉢上でかき混ぜながらボロシロキサン電解質 0.324 g に S I S のトルエン溶液を加えた。フラスコに移し室温で 24 時間減圧乾燥させるとゴム状で硬い固体ブレンド電解質が得られた。

ボロシロキサン電解質と S I S とのブレンド系のプロトン導電率を図 8 に示す。高湿度条件下でかなり高いプロトン導電率を示すことがわかる。

また、詳細は示さないが、S I S の代わりにポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ナフィオン (登録商標) またはフッ化ビニリデン等の高分子を用いて同様の操作を繰り返すことにより、これらとボロシロキサン電解質とのブレンド系電解質を得た。これらは同様に優れたプロトン導電率を示した。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】図面
 【補正対象項目名】図 3
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【 図 3 】

